

英特磊科技股份有限公司
IntelliEPI Inc. (Cayman)
(IET-KY股票代號: 4971)



2025年第3季業績發表會

2025年11月14日

投資人關係聯絡資訊: investors@intelliepi.com

IntelliEPI 風險預告

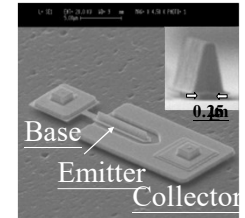
- 本次簡報包含對未來營運的看法。這些對於未來的看法基於許多假設，其中部分假設如大環境的變化可能超出公司的控制範圍，因此這些看法有其風險和不確定性。
- 因此公司未來發展的實際結果會因為這些不可控因素的變化，不同於現在這個時間點的看法。對於未來發生的資訊或事件，公司不承擔任何義務更新或修改本次的報告。

IntelliEPI 產品應用領域介紹

主要產品:

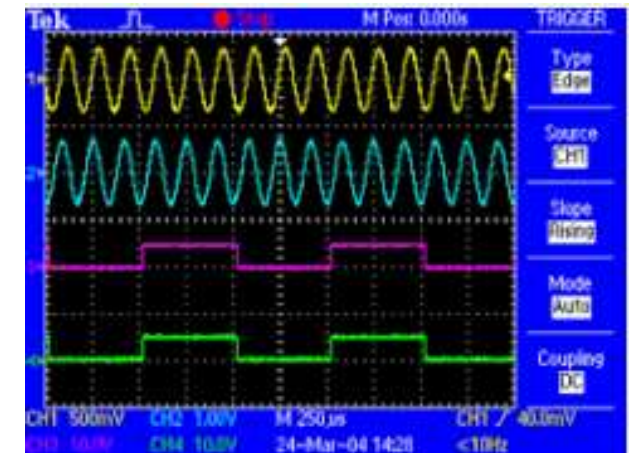
• 砷化鎵(GaAs)磊晶晶片

- pHEMT結構: 非行動通訊裝置, 有線電視 / 衛星通訊, 無線基地台, 車用電子 (EV、LiDAR)/ 防撞雷達, 太空 / 國防, 醫療, 測試與量測, 物聯網產業應用, 面射型雷射(VCSEL)
- 新興市場: 量子點(QD)雷射用於高速光通訊元件



• 磷化銦(InP)磊晶晶片

- 主要應用於高頻光纖網路, 高頻量測儀器元件, 光通訊用光接收器於雲端計算、資料庫、資料傳遞應用, 5G基礎建設, 車用通訊PA
- 新市場機會: AI Data center interconnections. 5/6G手機PA, 穿戴式與感測裝置, 車用LiDAR接收器, InP PIC (Photonic IC)



IntelliEPI 產品應用領域介紹

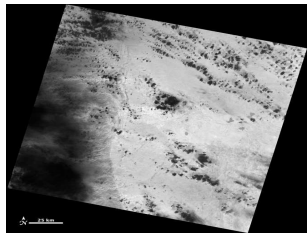
主要產品：

- 銻化鎵(GaSb)紅外線探測器磊晶晶片
 - 政府特殊應用計畫: 聚焦平面列陣(FPA)關鍵材料，主要應用於夜視、保全、國土安全、太空科技等用途
 - 垂直整合大尺寸銻化鎵(GaSb)基板材料
 - 商業公司: 主要應用於夜視、保全
 - 新興市場: 生物電子辨識，溫室氣體偵測
- 氮化鎵(GaN)磊晶晶片, 二次磊晶
 - 5G網路基站PA，5G基礎建設
 - 高頻高電壓元件，功率轉換器，AI資料庫功率轉換器

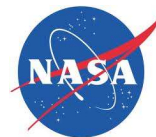


銻化鎵單晶

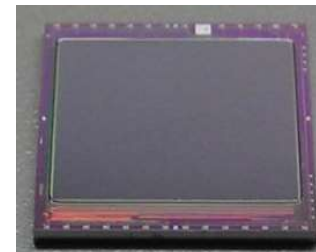
Raytheon



美國太空總署紅外線衛星攝影於地球表面



聚焦平面列陣 (FPA)
紅外線熱影像
T2SLS epi-structure



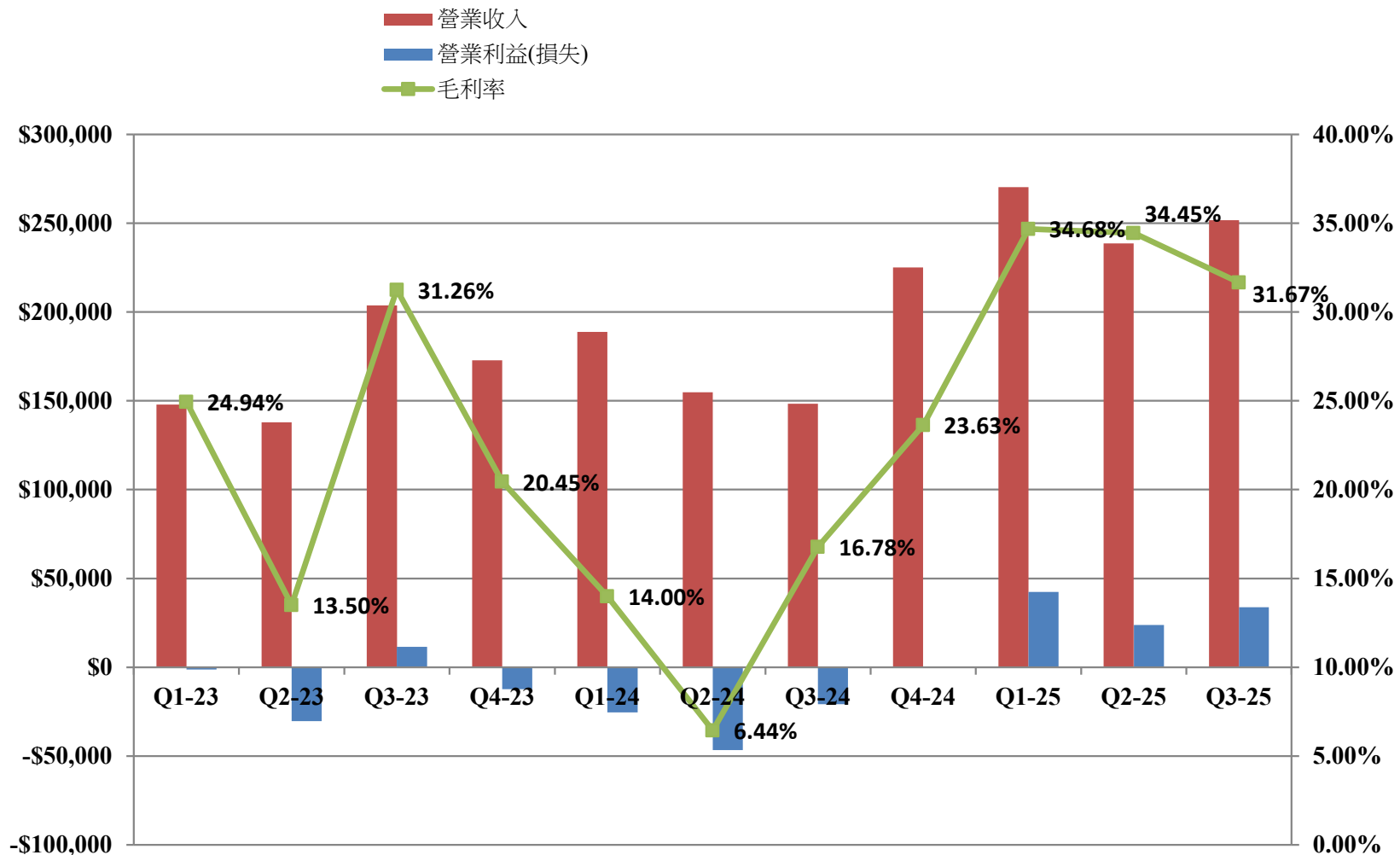
聚焦平面列陣 (FPA)



銻化鎵磊晶片

財務報告

IntelliEPI 季營業額及毛利趨勢圖



單位: 新台幣仟元

	Q1-23	Q2-23	Q3-23	Q4-23	Q1-24	Q2-24	Q3-24	Q4-24	Q1-25	Q2-25	Q3-25
營業收入	\$147,904	\$137,865	\$203,809	\$172,777	\$188,887	\$154,847	\$148,309	\$225,192	\$270,389	\$238,685	\$251,751
營業利益(損失)	-\$1,274	-\$30,338	\$11,444	-\$12,409	-\$25,406	-\$46,631	-\$20,749	-\$156	\$42,444	\$23,794	\$33,755
季成長率	-29.8%	-6.8%	47.8%	-15.2%	9.3%	-18.0%	-4.2%	51.8%	20.1%	-11.7%	5.5%
毛利率	24.94%	13.50%	31.26%	20.45%	14.00%	6.44%	16.78%	23.63%	34.68%	34.45%	31.67%

IntelliEPI 2025年第3季合併損益表(IFRSs)

單位：新台幣仟元	2024第3季	佔營收 比率	2025第2季	佔營收 比率	2025第3季	佔營收 比率	QoQ	YoY
營業收入	\$148,309		\$238,685		\$251,751		5.5%	69.7%
營業成本	(123,423)		(156,458)		(172,030)			
營業毛利	24,886	16.8%	82,227	34.5%	79,721	31.7%	-3.0%	220.3%
營業費用	(45,635)	30.8%	(58,433)	24.5%	(45,966)	18.3%	-21.3%	0.7%
營業淨利	(20,749)	14.0%	23,794	10.0%	33,755	13.4%	41.9%	262.7%
營業外收入及支出	(27,555)		1,016		537			
稅前淨利	(48,304)		24,810		34,292			
所得稅(費用)利益	2,589		8,664		(4,336)			
稅後淨利	(\$45,715)	30.8%	\$33,474	14.0%	\$29,956	11.9%	10.5%	165.5%
基本每股盈餘(單位：元) \$	(1.25)		\$ 0.84		\$ 0.75			
資產報酬率	-2.3%		1.7%		1.5%			
股東權益報酬率	-2.8%		1.9%		1.6%			

IntelliEPI 2025年第3季合併資產負債表(IFRSs)

單位：新台幣仟元	9/30/2024		6/30/2025		9/30/2025	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金	188,208	9.7%	111,680	5.9%	113,215	5.7%
應收帳款淨額	123,826	6.4%	152,441	8.1%	182,237	9.1%
存貨	233,060	12.0%	195,527	10.4%	209,744	10.5%
其他流動資產	110,772	5.7%	150,094	7.9%	167,756	8.4%
流動資產合計	655,866	33.7%	609,742	32.3%	672,952	33.7%
不動產，廠房及設備	1,231,285	63.2%	1,158,536	61.3%	1,262,614	63.1%
無形資產	493	0.0%	211	0.0%	20,552	1.0%
其他非流動資產	59,545	3.1%	120,646	6.4%	43,533	2.2%
資產總額	1,947,189	100.0%	1,889,135	100.0%	1,999,651	100.0%
流動負債	324,955		90,025		99,897	
非流動負債	1,669		6,006		5,750	
負債總額	326,624	16.8%	96,031	5.1%	105,647	5.3%
股東權益	1,620,565	83.2%	1,793,104	94.9%	1,894,004	94.7%
負債與股東權益總額	1,947,189	100.0%	1,889,135	100.0%	1,999,651	100.0%
負債比率	16.8%		5.1%		5.3%	
流動比率	201.8%		677.3%		673.6%	
速動比率	118.3%		368.0%		365.0%	

IntelliEPI 主要產品別銷貨收入

年度 產品別	2021	2022	2023	2024	1Q 2025	2Q 2025	3Q 2025
	比率	比率	比率	比率	比率	比率	比率
砷化鎵(GaAs)磊晶片	27.8%	27.4%	37.5%	34.1%	25.4%	27.7%	26.9%
磷化銦(InP)磊晶片	43.1%	54.3%	35.4%	38.5%	54.1%	50.4%	43.1%
銻化鎵(GaSb)及勞務收入	28.7%	18.0%	24.4%	24.1%	18.1%	20.0%	28.6%
其他	0.4%	0.3%	2.7%	3.3%	2.5%	1.9%	1.4%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

IntelliEPI 產品別依主要應用市場

年度 應用型態	2020	2021	2022	2023	2024	1Q 2025	2Q 2025	3Q 2025
	比率	比率	比率	比率	比率	比率	比率	比率
射頻(物聯網，航太，無線通訊)	11.4%	8.3%	10.7%	19.1%	16.0%	13.0%	12.0%	9.3%
汽車防撞及車用	12.4%	12.5%	9.2%	14.0%	10.7%	9.0%	12.0%	5.6%
光纖網路	29.8%	29.1%	33.9%	20.1%	32.8%	39.0%	39.0%	44.8%
高速傳輸元件	16.6%	20.0%	25.6%	23.5%	16.3%	21.0%	17.0%	12.3%
紅外線偵測	16.2%	13.1%	10.5%	13.7%	20.6%	14.0%	12.0%	20.2%
硬體構件	13.6%	17.0%	10.1%	9.6%	3.5%	4.0%	8.0%	7.9%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

營業策略與計劃

IntelliEPI: 營運策略與計劃

堅持品質與績效管理，執行新廠二期擴建，德州晶片法案請款，及繼續聯邦晶片法案談判。同時專注於開拓下列磊晶產品與國際市場：

磷化銦：持續為今年明年生產重心。大廠對磷化銦PIN磊晶片訂單持續放量，壓縮交貨期，下一年度的量產訂單洽談中。磷化銦基板供貨仍吃緊，大廠提供基板的生產模式降低基板不足的壓力，第4季的重心為持續優化機台產能與效率，爭取銷售額。

砷化鎵：高速（100G）VCSEL磊晶片器件性能已達客戶預期，200G VCSEL磊晶片器件性能測試中，產品持續開發進行認證，另外pHEMT與mHEMT磊晶片需求與出貨穩定，與國防大廠洽談開發高端光電磊晶產品及專用量產機台。

銻化鎵：客戶需求穩定，部份國防訂單受美國政府關門而受影響，相信情況改善後可持續接獲新訂單。

硬體構件：MBE機台訂單已開始依約請款並依完工比例認列收入，多家客戶持續詢問購買不同型MBE機台事宜，或承包產能方案，公司將進一步爭取訂單。

氮化鎵（GaN）：氮化鎵二次長晶已有部份客戶完成認證，將進一步爭取量產訂單。第二台自用氮化鎵MBE完成安裝，進入測試生產。

IntelliEPI

Q & A

IntelliEPI

關於本公司其他資訊請上公司網站

www.intelliepi.com

如有其他諮詢、建議、評論請洽

investors@intelliepi.com